





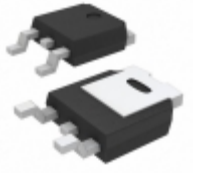




 life.augmented	<h2>STD6NM60N</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STD6NM60N</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 4.6A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STD6NM60N.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 79567 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STD6NM60N</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 4.6A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	79567 pcs Stock
Serie	MDmesh™ II
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	920 mOhm @ 2.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	420pF @ 50V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STD6NM60N ist neu im Original, Suche STD6NM60N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD6NM60N STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STD6NM60N: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STD6NM60Z</b> IPS STD6NM60Z IPS	 <b>STD6NF10T4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 6A DPAK	 <b>STD6NF10-1</b> VBsemi STD6NF10-1 VBsemi	 <b>STD6NK50ZT4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 5.6A DPAK
 <b>STD6NF10</b> ST STD6NF10 ST	 <b>STD6NM60-1</b> ST STD6NM60-1 ST	 <b>STD70GK12</b> Sirectifier IGBT Modules	 <b>STD6NM60N-1</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 4.6A IPAK

### heiße Teile

Mehr

⊗ STD60NF3LLT4	↔ STD60NF55	⇒ STD60NF55L	D STD60NF55L-1	↔ STD60NF55LA
⊣ STD60NF55LAT4	⊗ STD60NF55LAT4	D STD60NF55LT4	⇒ STD60NH03LT4	↔ STD616A-1
⊗ STD616AT4	⊣ STD64N4F6AG	⊗ STD65N3LLH5	↔ STD65N55F3	↔ STD65N55LF3
D STD65N55T4	⊗ STD65N6F3	⊣ STD65NF06	⊗ STD6N10T4	↔ STD6N52K3
⇒ STD6N62K3	↔ STD6NF10	⊗ STD6NF10-1	⊣ STD6NF10T4	↔ STD6NK50ZT4
↔ STD6NM60N-1	⇒ STD70GK08	D STD70GK08B	⊗ STD70GK12	⊣ STD70GK12B
⊗ STD70GK14	D STD70GK14B	⇒ STD70GK16	↔ STD70GK16B	↔ STD70GK18
⊣ STD70GK18B	⊗ STD70N02	↔ STD70N02L	⇒ STD70N02L-1	↔ STD70N02LH5
⊗ STD70N03L	⊣ STD70N03LT4	⊗ STD70N10F4	D STD70N2LH5	↔ STD70N6F3
↔ STD70NH02L	⊗ STD70NH02LT4	⊣ STD70NS04ZL	⊗ STD75N3LLH6	↔ STD7N52DK3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited